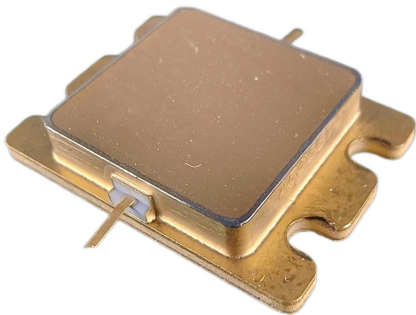


C-Band Internally-Matched Power Transistor

产品特性：

- 工作频率 5.80-6.70GHz
- 饱和输出功率 Psat ≥ 51dBm
- 功率增益 Gain ≥ 10.0dB
- 工作效率 η ≥ 45%
- 端口匹配 Zin/Zout=50Ω



产品说明：

HXN40073是一款氮化镓内匹配功率管，采用先进的平面内匹配合成技术和成熟的薄膜混合集成工艺，产品的典型工作频带为 5.8-6.7GHz，具有高功率、高效率及温度等环境适应性等特点，能够广泛应用于各种射频/微波系统中。

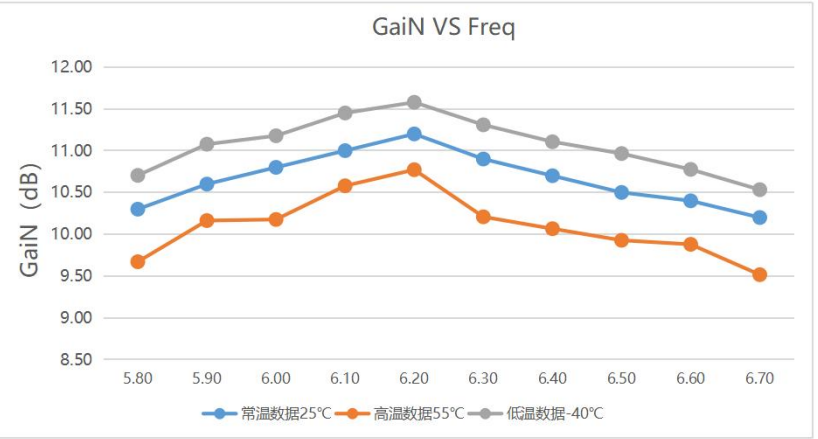
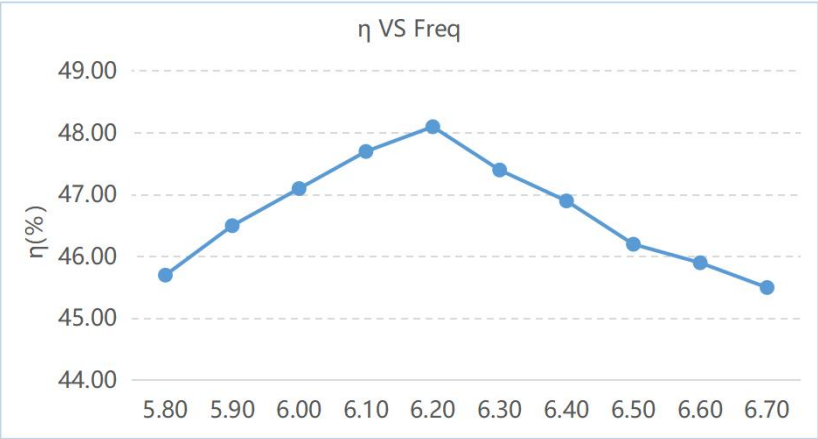
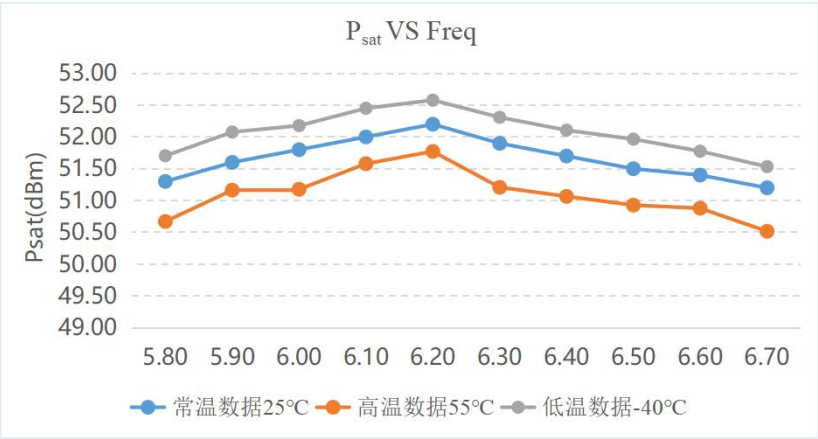
最大额定值（TC=25℃，不推荐在此条件下工作）：

参数	符号	值	单位
漏源电压	V_{DS}	40	V
栅源电压	V_{GS}	-5	V
存储温度	T_{stg}	-65 to +150	℃
沟道温度	T_{ch}	150	℃

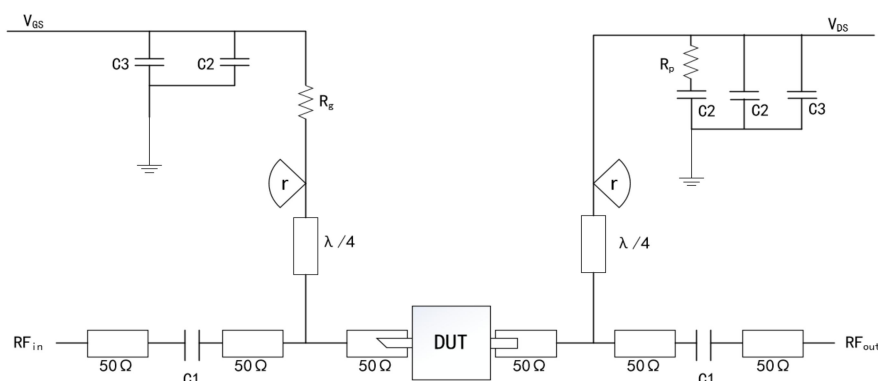
微波电性能：

参数	符号	测试条件	值 Min	Typ	Max	单位
漏极电流	I_{dsr}	V_{DS} : 28V 连续波工作 Pin: 41dBm Freq: 5.8-6.7GHz	-	10	-	A
饱和输出功率	Psat		51	-	-	dBm
功率增益	G_p		10	-	-	dB
工作效率	η		45	-	-	%
增益平坦度	ΔG		-0.8	-	0.8	dB

典型曲线



推荐应用电路：



r半径 $\approx$ 4.5mm (Rogers5880, 20mil)

ESD	Class III	2000V
-----	-----------	-------

Technical drawing of a mechanical part, showing a top view and a side view. The top view is a square with rounded corners, featuring a central square hole and four circular holes near the corners. Dimensions include overall width 20.4, overall height 17.4±0.15, and various hole diameters and positions. The side view shows a rectangular block with a top surface dimension of 24±0.20 and a total height of 4.4±0.25. Surface texture symbols are present on the top and side surfaces.

- 运输存储过程中注意干燥。
- 芯片使用、装配过程中注意防静电，戴接地防静电手镯。
- 加电时先加栅电再加漏电。